

Samsung MZ-V9S4T0 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC

Ref.: HD34651201 P/N: MZ-V9S4T0BW



Detalle del producto

- 4 TB M.2 PCI Express 4.0
- Velocidad de lectura: 7250 MB/s 1050000 IOPS
- Velocidad de escritura: 6300 MB/s 1400000 IOPS
- V-NAND TLC NVMe 2.0
- Encriptación de hardware 256-bit AES
- Soporte S.M.A.R.T. Soporte TRIM
- Componente para: PC

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) 4 TB M.2 PCI Express 4.0 Velocidad de lectura: 7250 MB/s 1050000 IOPS Velocidad de escritura: 6300 MB/s 1400000 IOPSV-NAND TLC NVMe 2.0 Encriptación de hardware 256-bit AES Soporte S.M.A.R.T. Soporte TRIM Componente para: PC SDD, capacidad 4 TB

Factor de forma de disco SSD M.2

Interfaz PCI Express 4.0

NVMe Si

Versión NVMe 2.0

Tipo de memoria V-NAND TLC

Componente para PC

Encriptación de hardware Si

Algoritmos de seguridad soportados 256-bit AES

Tamaño de la unidad SSD M.2 2280 (22 x 80 mm)

Velocidad de lectura 7250 MB/s

Velocidad de escritura 6300 MB/s

Lectura aleatoria (4KB) 1050000 IOPS

Escritura aleatoria (4KB) 1400000 IOPS

Función DevSleep Si

Soporte S.M.A.R.T. Si

Soporte TRIM Si

Voltaje de operación 3,3 V

Tiempo medio entre fallos 1500000 h

Consumo de energía (lectura) 5,5 W

Consumo de energía (escritura) 4,8 W

Consumo de energía (espera) 0,06 W

Ancho80,2 mm

Intervalo de temperatura operativa0 - 70 °C

Consumo de potencia DevSlp (modo sueño)5 mW

Profundidad2,38 mm

Altura80,2 mm

Golpes en funcionamiento1500 G

Peso9 g

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*